

OTP_Writer (Ver.C) 与 NY8-OTP_Writer (Ver.A) 之扩充修改

内容: OTP_Writer (Ver.C) 与 NY8-OTP_Writer (Ver.A) 的电路板须做扩充修改以支持未来新的 Nyquest OTP IC。

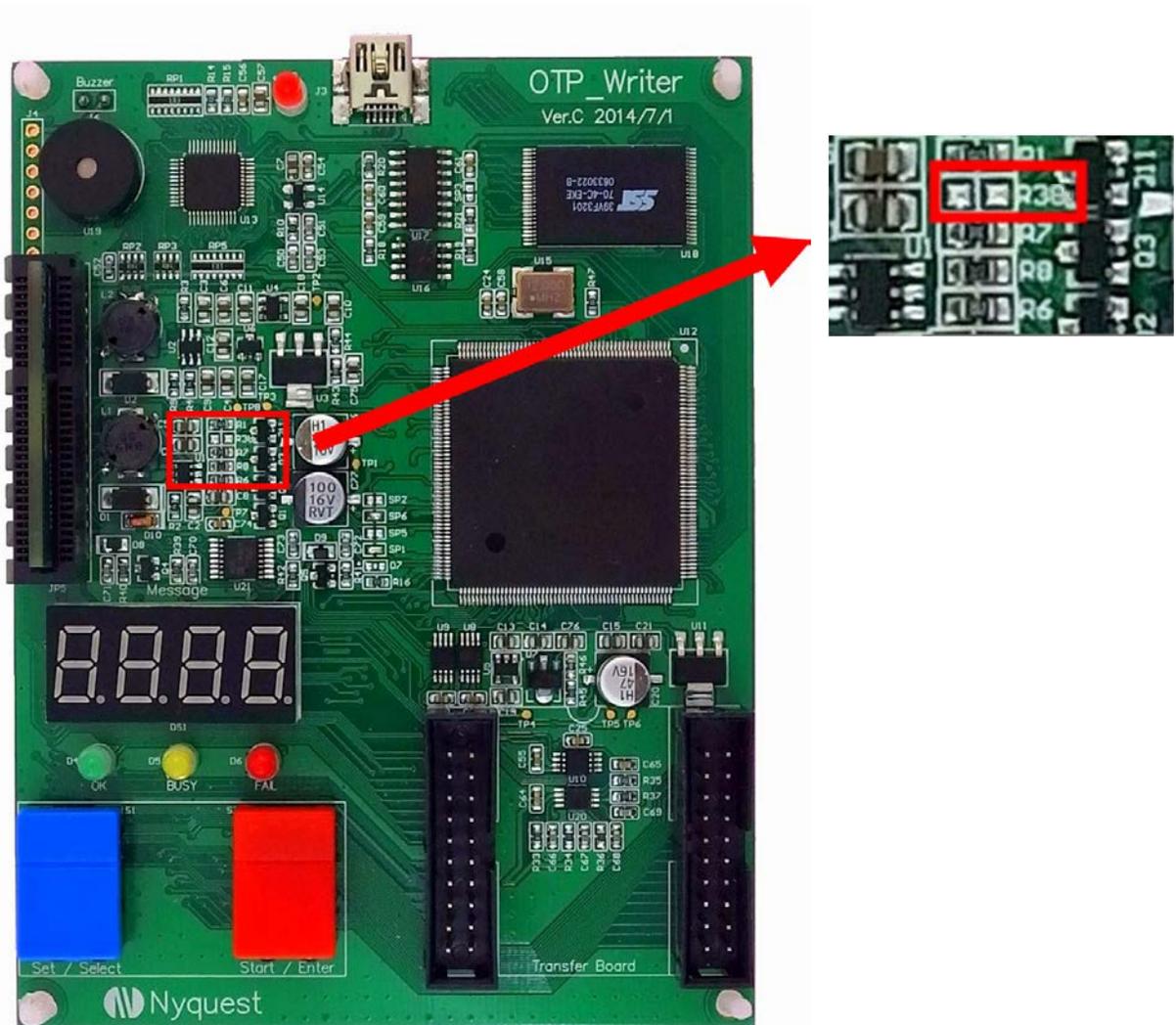
原因: 为支持未来更多新产品 OTP IC 的烧录电压，OTP_Writer (Ver.C) 与 NY8-OTP_Writer (Ver.A) 必须做扩充修改，以因应未来 OTP 烧录的需求。

方法: 请用户依下述步骤自行修改：

1. OTP_Writer (Ver.C) 电路板修改方式

将 R38 增加焊接 18KΩ +/-1% 电阻。

OTP_Writer (Ver.C) 电路板 R38 位置如下图：



2. NY8-OTP_Writer (Ver.A) 电路板修改方式

- A. 将 R33 增加焊接 22KΩ +/-1% 电阻。
- B. 将 R34 增加焊接 1.5KΩ +/-1% 电阻。

NY8-OTP_Writer (Ver.A) 电路板 R33 与 R34 位置如下图:

